国泰海通证券股份有限公司

关于江苏神州半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年十一月

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏神州半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国泰海通”）接受江苏神州半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“神州半导体”、“公司”）的委托，担任神州半导体首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

一、发行人基本情况.....3
二、发行人本次发行情况.....20
三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....20
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.....21
五、保荐人承诺事项.....22
六、保荐人对本次发行上市的推荐结论.....23
七、本次证券发行上市履行的决策程序.....23
八、保荐人关于发行人符合科创板定位及国家产业政策的说明.....23
九、保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明.....26
十、保荐人对发行人持续督导工作的安排.....31

一、发行人基本情况

（一）基本信息

中文名称	江苏神州半导体科技股份有限公司
英文名称	Jiangsu Shenzhou Semiconductor Technology Co., Ltd.
注册资本	6,600 万元
法定代表人	朱培文
有限公司成立日期	2016-04-26
股份公司设立日期	2025-12-09
注册地址	扬州市邗江区蜀岗西路 19 号 1
主要生产经营地址	扬州市邗江区蜀岗西路 19 号 1
邮政编码	225100
电话	0514-87958862
传真	0514-87958862
互联网网址	https://www.szsemicon.com
电子信箱	ir@asiaexact.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人	丁昊
信息披露和投资者关系电话	0514-87958862
经营范围	半导体设备及配件的研发、生产、制造、维修；电源、电子机械设备维修；电气工业设备安装调试；软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；电子器材、五金交电、环保设备、照相器材、金属材料、高低压电器、通讯器材、电子产品、电线电缆、机械设备制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件销售；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次证券发行类型	人民币普通股（A 股）

（二）主营业务

公司主要从事半导体关键工艺设备核心零部件的研发、生产、销售和技术支持服务，以半导体制造关键工艺技术——等离子体源技术为基础，为我国半导体先进制程产业链提供高端等离子体电源系统产品和全方位技术支持服务。

公司自设立以来，始终瞄准世界半导体技术前沿，坚持自主研发创新，以先进制程等离子体电源系统自研产品业务与全方位技术支持服务为双轮驱动，在保障国内存量芯片产线稳定运行的同时，持续加速等离子体电源系统等半导体核心零部件的国产化进程，为提升我国半导体产业链供应链韧性与安全水平提供核心支撑。

在保障存量产线稳定运行方面，当芯片产线设备电源系统出现失准、老化、损毁等问题，公司为其提供检测、维修、定制化性能升级等专业的技术支持服务，保障客户芯片产线快速恢复正常运转及制程调整等要求。公司以深厚的技术积淀，有效填补了国际原厂技术支持服务收缩形成的市场缺口，为国内芯片产线破解“停机风险”、保障产业安全稳定发展提供关键支撑。目前，公司已发展成为国内规模领先的等离子体电源系统专业技术支持服务商，服务覆盖客户 A、台积电、英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、客户 B、客户 E、客户 C、客户 D、华润微等国内外主流芯片产线，以及应用材料、中微公司、拓荆科技、北方华创等国内外知名半导体设备厂商。

在推进核心零部件国产化进程方面，公司成功填补国产半导体设备高端等离子体电源系统的应用空白，成功研发了远程等离子体源系统、等离子体射频电源系统等系列产品，产品性能全面对标国际品牌同类产品，批量导入中微公司、拓荆科技、北方华创等国内头部半导体设备厂商，适配于国内头部芯片产线。目前公司产品已大规模应用于 14 纳米及以下逻辑芯片、2XX 层及以上存储芯片先进制程产线。

公司不断进行半导体前沿技术追赶，在持续研发迭代远程等离子体源系统、等离子体射频电源系统的同时，成功研发出适配高深宽比刻蚀工艺的新型电源方案——高压脉冲电源系统，该方案系未来实现 4XX 层级别芯片制程不可或缺的核心配套技术方案之一，为我国半导体先进制程“高深宽比”场景下的三维异构集成等前沿技术突破提供核心底层支撑。此外，公司还完成了 ESC 吸附电源、ESC 加热电源、溅射电源等多项储备产品的研发工作，进一步丰富了公司自研产品矩阵。

通过持续技术创新，公司实现了从技术突破、产品落地到产品矩阵多元拓展的跨越式发展，积极为我国半导体产业提供自主可控的核心零部件产品，为我国

半导体制造关键技术自主可控构筑坚实保障。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（三）核心技术与研发水平

1、主要产品核心技术应用概况

经过多年实践积累与创新探索，公司自研形成了 14 项“关键性基础技术+产品化支撑技术”的双层架构核心技术体系。

其中，5 项基础技术是公司产品及服务的底层技术基石，包括等离子体电源精准测量分析技术、等离子体电源数字化精准控制技术、等离子体射频高功率功放技术、系统智能故障监测与诊断技术、高精度智能测试仿真平台技术。上述核心技术是公司全系列产品及服务电路设计优化、精准测量、数字化控制、智能测试、模拟产线适配的核心底层支撑，从新型拓扑结构、宽禁带半导体应用、全流程数字化管控等维度，构建了等离子体电源系统的底层技术壁垒。

9 项产品化支撑技术，是针对半导体先进制程场景的定向技术突破，包括高精度功率和阻抗校准技术、射频激励等离子体均匀稳定技术、多频多路智能化功分匹配技术、基于模型预测与微调的自动阻抗匹配技术、耐腐蚀长寿命阳极氧化膜技术、高流量高解离率稳定点火技术、可重构高功率密度高压直流技术、离子能量可控源技术、低储能快速弧反应电源技术。上述技术针对半导体先进制程对工艺效果、稳定性的严苛要求定向开发，精准匹配刻蚀、薄膜沉积等核心工艺需求，与基础技术共同形成了公司全品类产品及服务的核心竞争力。

公司自研形成的多项核心技术均已实现商业化，广泛应用在公司自研产品及技术支持服务中，主要情况如下：

技术类别	核心技术名称	技术主要内容	技术先进性及具体表征	所处阶段
基础技术	等离子体电源精准测量分析技术	该技术通过高速高分辨率模数转换模块与自主设计的宽频带、高线性度采样电路等，对电源输入/输出参数进行同步实时采集，结合数字模型算法，能够准确测量及分析复杂工况下的电流、电压、有效功率、阻抗及谐波分量等关键参数，该技术系电源系统精准控制的支撑技术。	①检测范围宽：该技术可以实现高动态功率范围检测，在小功率模式下亦可实现精准检测，能适配多种复杂的半导体工艺环境；②检测精度高：该技术基于复杂的阻抗空间校准技术、可编程增益与自适应量程切换技术、先进传感与数据融合技术等，动态范围内实现电压、电流、相位、功率等精准测量取样，平均测量精度±1%，最高可达 0.5%；③快速测量分析：该技术基于高速高分辨率模数转换模块和独特的数字信号处理算法，可实现待测参数的纳秒级实时测量和分析。	批量生产

技术类别	核心技术名称	技术主要内容	技术先进性及具体表征	所处阶段
	等离子体电源数字化精准控制技术	该技术以全数字化架构取代传统模拟控制系统，通过高速并行处理能力实现等离子体电源功率、频率、相位等参数的实时精准调控，使等离子体电源系统输出具备更高的稳定性和动态响应能力，为等离子体工艺提供稳定可靠的功率驱动能力。	①控制精度高：该技术基于数字化控制极大降低功率控制偏差，频率调谐精度 kHz 级，相位精度<0.5°；②自适应频率调谐能力强：在腔室阻抗快速漂移情况下，显著提升等离子体维持稳定性；③快速控制：数字化架构支持高速指令链路与并行处理，可实现毫秒级输出功率斜坡控制、纳秒级同步控制、包络脉冲上升/下降沿等。	批量生产
	等离子体射频高功率功放技术	本技术采用新一代功率器件，通过 3 级以上的多级功放合路及拓扑平衡模式，能够实现射频高功率合成，可形成 7kW 高可靠性单功放模组，并兼具小体积特点。	①功率等级高：本技术通过合适功放架构能够合成 50kW 以上的高功率，满足高深宽比刻蚀场景等对高功率的需求；②可靠性高：在多个不同频率/功率射频电源工作下，存在高驻波或各种交调量影响，电源系统易损坏，本技术采用拓扑平衡模式确保电源系统高可靠性；③高功率密度：通过优化散热通道、提升功放转换效率以实现更高的功率密度。	批量生产
	系统智能故障监测与诊断技术	该技术通过构建“多物理场参数融合+专项故障算法”诊断模型，结合硬件集成采集技术等，能够覆盖输入/输出电路短路、阻抗失配、电机故障、温度异常等故障场景，有效识别用户机台工艺过程中的各项异常情况，有效支撑刻蚀、镀膜等关键工艺设备的稳定、安全、可靠运行。	①全参数实时监测：覆盖射频类（功率、阻抗、频谱等）、RPS 类（温度、流量、功率、解离率等）、匹配器类（电容转矩、误差值等）等多项核心参数，采集频率可达微秒级；②多范围故障识别：包括阻抗失配、功率异常、水路系统故障等故障类型识别判断，故障检测精度高；③基于全参数的精准故障监测，保障客户产线工艺稳定运行。	批量生产
	高精度智能测试仿真平台技术	通过采集模块集成技术、分布式控制技术、智能算法、多维度参数协同测控架构、可视化人机交互技术等，为半导体制程等离子体电源系统提供产线模拟运行测试，以保障产品工艺稳定性与一致性的仿真系统。	①多维度数据采集：采用模块化集成设计，整合高精度模拟量采集模块、高速数字量采集模块、顶尖精密测试仪器集群，可实现模拟量、数字量、射频量等多类型核心参数的并行测量；②测试精度高、范围广：测试功率最高可达 100kW，频率可达 2.45GHz，功率测量精度控制在±0.5%，频率测量精度可达 0.1Hz，阻抗匹配时间测量精度可达 1 毫秒，模拟电压测量精度可达 0.1mV；③通信兼容性全面：可适配 Analog、Profibus、EtherNet、EtherCat 等全类型通讯端口连接；④仿真模拟智能化：结合公司自主开发智能算法，能够模拟等离子体电源系统在产线端的工况运行状态。	批量生产
产品化支撑技术	高精度功率和阻抗校准技术	该技术基于链路传输模型对射频传感器采样信号进行精准补偿，实现与 VNA 级别相近的校准效果，保障等离子体射频电源系统在先进半导体制程中的精准能量输出。	①全链路补偿，消除关键误差源：传统校准受寄生参数、反射干扰、温漂等影响，本技术通过全链路建模和数字补偿，可显著降低上述影响带来的误差，保障半导体等离子体工艺的一致性；②宽频宽量程校准能力：系统支持多频段、高动态范围射频信号的校准，可覆盖刻蚀、薄膜沉积等半导体工艺应用场景。	批量生产

技术类别	核心技术名称	技术主要内容	技术先进性及具体表征	所处阶段
	射频激励等离子体均匀稳定技术	本技术通过高频脉冲调制技术，采用延迟补偿与自适应算法，高线性度功放链路设计，多维度快速电弧检测与分级抑制策略，能够有效抑制驻波效应与电荷积累、降低电弧影响，从而显著改善半导体工艺均匀性、一致性、安全性。	①电弧抑制：通过检测反射功率和配置脉冲时序参数，可快速抑制电弧，避免电弧损伤晶圆及腔室；②高频脉冲调制：本技术可实现 500kHz 脉冲调制频率，纳秒级最小脉宽，搭配直流脉冲电源可实现同步高频脉冲，从而获得更高的电子密度稳定性和阻抗稳定性，实现离子能量分布的精准控制；③高线性度功放：本技术通过先进线性功放架构、高效的线性补偿和波形控制，可有效控制谐波分量，实现波形塑形。	批量生产
	多频多路智能化功分匹配技术	该技术通过多通道运算、智能功分算法闭环控制，结合传感模块实时监控多频段射频参数，自适应调节各通道功率或电流等差异，实现射频电源系统在薄膜沉积、刻蚀工艺中一腔多站等功分匹配应用，有效提升工艺设备空间利用率。	①多频多路智能功分：该技术可根据多路阻抗差异进行自适应功率或电流等调节，能够实现半导体工艺一腔多站功率或电流等参数比例调节；②宽范围电流比在线切换：该技术支持宽范围电流比毫秒级在线切换，如从 10%跳变至 90%，同时支持阻抗自适应匹配，降低系统反射，有效满足半导体工艺对等离子体的动态需求。	批量生产
	基于模型预测与微调的自动阻抗匹配技术	基于 S 参数模型与微调的自动匹配算法，构建了硬件与算法的映射模型，计算实时阻抗，实现更快速的等离子体阻抗匹配。	传统方案存在阻抗匹配慢、容易在目标值附近振荡，造成电容落点偏差大。该技术下阻抗匹配速度可达毫秒级，电容运动曲线一致性高、重复性好，即使在等离子体阻抗剧烈、快速变化的工艺中，也能实现快速跟随和匹配。	批量生产
	耐腐蚀长寿命阳极氧化膜技术	采用二次脉冲阳极氧化工艺，结合沸水封孔、预钝化、水合钝化和协同钝化等多重复合处理，通过调节膜层 OH 键覆盖密度，有效提升氧化膜使用寿命和产品功率运行窗口。	①耐蚀性能强：通过三次封孔方式相结合的后处理与清洗工艺，促进 Al_2O_3水合反应，堵塞孔隙，提升腔体阳极氧化膜层的硬度，解决了膜层厚度不均、易开裂腐蚀及杂质残留等关键难题，提升了膜层耐腐蚀性；②工艺适应性强：通过影响氧化膜层表面 OH 键覆盖密度，降低 RPS 功率运行窗口下限，满足了 FCVD 等工艺的沉积速率需求，提升了膜层工艺的稳定性与适用性；③成本效益好：该技术下腔体寿命有效延长，客户单台 RPS 设备年维护成本降低约 40-50%。	批量生产
	高流量高解离率稳定点火技术	该技术采用“预激发+主点火”双阶段算法设计，能够实现在不同流量、压力下稳定点火并实现气体高效稳定解离，为远程等离子体源系统在复杂工况下提供高可靠性、高解离率性能。	①高点火成功率：在 10-50SLM 高流量、混合气体组分实现气体的稳定点火，有效减少工艺停机时间；②高解离率水平：该技术下实现 NF_3、NH_3、O_2等制程气体的高效、稳定解离，有效提高刻蚀、薄膜沉积等工艺一致性。	批量生产
	可重构高功率密度高压直流技术	该技术采用了宽禁带功率器件的模块化单元与智能总线架构技术，实现高功率密度的宽范围高压直流输出，同时支持柔性化拓展、多路独立输出、极性快速切换等核心功能。	①可重构架构：传统高压直流电源受限于刚性架构，设备功能存在固化局限，该技术采用无主从并联智能总线架构，突破传统架构功能边界，实现设备“一机多用”与“弹性扩容”；②高功率密度：基于宽禁带功率器件与谐振变换器拓扑，功率密度最高可达 700W/L，电压范围覆盖 0-15kV，在同等功率输出场景下，产品体积显著缩小，单位散热能耗降低，有效助力客户节省机台空间与能耗成本。	批量生产

技术类别	核心技术名称	技术主要内容	技术先进性及具体表征	所处阶段
	离子能量可控源技术	该技术采用多开关调制架构，结合高频脉冲时序同步技术，生成对称或非对称等复杂脉冲波形，实现对离子轰击能量与电荷中和效应的解耦及精细控制。	离子能量可控：传统等离子体源方案受限于正弦波输出模式，离子能量呈宽谱分布（跨度达百级 eV），控制精度低，导致工艺均匀性相对较差；该技术可实现对复杂波形的精细控制，精准调控离子能量，实现 eV 单位范围的离子能量分布，控制精度显著提升，工艺均匀性优于传统方案，可实现原子层级的半导体工艺应用。	批量生产
	低储能快速弧反应电源技术	该技术运用超低电感回路设计、高频逆变式斩波技术，融合快速电弧检测与抑制算法，能够实现高效电弧管理，进而提升薄膜质量和靶材利用率。	①高效电弧管理：传统方案存在电弧抑制响应慢、消弧不充分的痛点，该技术能够实现快速电弧抑制，从传统毫秒级缩短至微秒级，从根源上规避电弧残留对设备的损伤风险；②电源低储能：传统方案因电源储能冗余度高，单次异常能量释放可达上百焦耳，易引发靶材损伤和薄膜缺陷；该技术创新采用低储能电源架构，将单次异常能量释放严格限制在单位焦耳以内，为靶材、基材和薄膜层提供全方位保护。	工艺验证

2、主要产品核心技术水平概况

公司核心技术紧密围绕半导体先进制程对等离子体电源的核心需求研发，依托核心技术突破了多项海外巨头长期垄断的“卡脖子”技术难题，整体技术达到国际先进水平，部分核心指标实现国际领先，是公司主营业务发展的核心底层支撑，行业地位突出，相关技术先进性已获得国家级权威机构、下游头部客户的多重验证。

（1）国家级行业协会权威成果鉴定

中国电子专用设备工业协会组织评审，对公司的科研成果“高深宽比等离子体刻蚀设备用多级脉冲射频电源”出具了《科学技术成果鉴定证书》（中电专设鉴字〔2026〕第 01 号），形成鉴定意见为：“项目针对多级脉冲射频电源高功率、高稳定性等技术瓶颈，结合高深宽比刻蚀设备制程的应用需求，研制了多级脉冲射频电源产品。项目成果配套国内头部半导体设备供应商，并在国内主流生产线批量应用，实现了进口替代，解决了高深宽比刻蚀设备关键核心部件的“卡脖子”问题。项目成果填补了国内空白，主要技术指标达到国际同类产品先进水平。”

中国电工技术学会组织院士领衔的专家组评审，对公司的科研成果“半导体芯片制程用高解离率高稳定性耐腐蚀远程等离子体源关键技术及应用”出具了《科学技术成果鉴定证书》（电技鉴字〔2025〕第 164 号），形成鉴定意见如下：“项目针对远程等离子体源高解离率、高稳定性、可靠激发以及耐腐蚀阳极氧化

膜等技术瓶颈，结合半导体芯片不同制程工艺应用的技术需求，研制了系列化远程等离子体源产品。该项目成果填补了国内空白，整体技术达到国际先进水平，其中远程等离子体源功率稳定控制和脉冲均流阳极氧化技术处于国际领先水平。”

（2）下游头部设备厂商官方技术水平认证

根据中微公司、拓荆科技出具的《产品技术水平评估与应用证明》，主要如下：

出具主体	证明名称	具体表述
中微公司	《阻抗匹配器（Match）技术水平评估与应用证明》	神州半导体提供的阻抗匹配器（Match），系列产品总体性能达到国际同类产品同等水平，关键技术参数对齐国际同类产品，实现了对国际品牌的国产化替代。系列阻抗匹配器（Match）已安装于我司刻蚀设备、薄膜沉积设备、物理气相沉积设备，在多种工艺制程上实现了在客户端的稳定测试。某款型号 Match 应用于刻蚀设备，产品总体性能达到国际同类产品同等水平。某款型号 Match 应用于薄膜沉积设备，产品整体技术指标满足客户需求，具有行业内先进水平。
	《射频功率发生器（RFG）技术水平评估与应用证明》	神州半导体提供的射频功率发生器（RF Generator），系列产品总体性能达到国际同类产品同等水平，关键技术参数对齐国际同类产品，实现了对国际品牌的国产化替代。多款型号射频功率发生器（RF Generator）已批量安装于我司等离子体刻蚀设备，客户端相关产品线已使用该设备实现量产。
	《远程等离子体源（RPS）技术水平评估与应用证明》	神州半导体提供的远程等离子体源（RPS），系列产品总体性能达到国际同类产品水平，部分关键技术参数已领先国际同类产品水平，实现了对国际品牌的国产化替代。多款型号远程等离子体源（RPS）已批量安装于我司刻蚀设备、薄膜沉积设备，在多种工艺制程上实现了在客户端的稳定量产。
拓荆科技	《远程等离子体源（RPS）技术水平评估与应用证明》	神州半导体自主研发系列 RPS，产品具备突出的先进性，系列产品总体性能达到国际同类产品水平，关键技术参数可对标国际同类产品水平。多款型号 RPS 已应用于我司等离子体增强化学气相沉积设备、原子层沉积设备、高密度等离子体化学气相沉积设备、流动性化学气相沉积设备，在多种工艺制程上实现了在客户端的稳定量产。

（3）行业与客户重磅奖项认可

公司凭借核心技术实力与全链条服务能力，斩获多项行业权威奖项，并获得头部客户的高度认可：荣获 2026 年中国证券报“2025 年度新质企业金牛奖（人工智能）”、公司荣获 2026 年 SEMICON“年度新锐企业奖”、中国 IC 独角兽联盟“2024-2025 中国半导体产线电源领军企业”“2024-2025 中国半导体产线电源最佳解决方案”、2026 年中微公司供应商“合作创新奖”“卓越质量进步奖”、2025 年拓荆科技全球合作伙伴“协作创新奖”、2025 年格科微零备件组“精诚服务奖”等。

3、发行人核心技术在主营业务中的应用和贡献情况

报告期内，公司所积累的核心技术已大量应用到主营业务中，营业收入主要来自核心技术贡献。

报告期内，公司的核心技术产品及服务收入占比情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品及服务收入	36,541.75	62,956.45	42,249.56	24,829.60
营业收入	37,545.34	65,424.00	44,627.90	26,105.54
核心技术产品及服务占营业收入的比例	**97.33%**	**96.23%**	**94.67%**	**95.11%**

（四）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产合计	117,620.58	104,335.88	53,752.19	31,118.05
非流动资产合计	22,099.54	18,384.98	10,957.65	7,084.80
资产总计	**139,720.11**	**122,720.86**	**64,709.84**	**38,202.85**
流动负债合计	15,909.71	12,079.49	8,454.28	6,990.28
非流动负债合计	1,916.37	1,429.14	1,846.66	2,045.87
负债合计	**17,826.08**	**13,508.63**	**10,300.94**	**9,036.15**
归属于母公司股东权益合计	121,894.03	109,212.23	54,408.90	29,166.70
股东权益合计	**121,894.03**	**109,212.23**	**54,408.90**	**29,166.70**

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	37,545.34	65,424.00	44,627.90	26,105.54
营业利润	12,870.22	22,886.55	15,374.58	-1,554.03
净利润	11,717.95	20,935.66	13,575.51	-2,231.88
归属于母公司股东的净利润	11,717.95	20,935.66	13,575.51	-2,157.60

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	4,660.59	22,926.66	1,718.86	2,045.63

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
投资活动产生的现金流量净额	-7,325.03	-7,471.95	-3,323.82	-7,016.96
筹资活动产生的现金流量净额	-144.66	31,377.53	9,515.17	-705.84
期末现金及现金等价物余额	56,257.45	59,197.93	12,404.98	4,459.65

4、主要财务指标

项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	7.39	8.64	6.36	4.45
速动比率（倍）	5.70	6.88	4.05	2.83
资产负债率（母公司）	12.38%	10.93%	14.81%	22.00%
资产负债率（合并）	12.76%	11.01%	15.92%	23.65%
应收账款周转率（次/年）	3.12	3.36	3.31	3.05
存货周转率（次/年）	1.07	1.02	0.91	1.11
息税折旧摊销前利润（万元）	14,121.89	25,254.62	17,220.70	-373.20
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	11,717.95	20,935.66	13,575.51	-2,157.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	10,941.86	19,827.12	13,359.95	5,639.27
研发投入占营业收入的比例	16.38%	16.69%	12.98%	14.05%
利息保障倍数（倍）	1,318.46	1,105.56	290.60	-23.65
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.71	3.47	-	-
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	18.47	16.55	-	-
每股净现金流量（元/股）	-0.45	7.09	-	-

注：上述财务指标的计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；
3、资产负债率=总负债/总资产；
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
6、息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+资本化利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销；
7、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息支出（包含资本化利息）；
8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
9、归属于公司普通股股东的每股净资产=期末归属于公司普通股股东的净资产/期末总股本；
10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本；
11、2026 年 1-6 月应收账款周转率、存货周转率已年化。

公司财务报告审计截止日为 2026 年 6 月 30 日。财务报告审计截止日至本上市保荐书签署日，公司经营情况良好，公司所处行业的产业政策等未发生重大不利变化，公司经营模式、采购、生产、销售情况均未发生重大变化，公司董事、

董事会审计委员会成员、高级管理人员、核心技术人员亦未发生重大变化，也未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

（五）发行人存在的主要风险

1、技术风险

（1）新技术、新产品研发失败风险

公司的等离子体电源系统属于半导体核心零部件，主要面向先进制程，需要持续进行高强度的研发投入。报告期内，公司的研发投入合计超过 2 亿元，且呈现高速增长的趋势。公司下游客户主要系国内半导体领域的头部芯片产线和设备厂商，下游客户有着持续的技术迭代需求，核心零部件厂商须持续配合下游客户，展开相应的技术攻关和研究探索。

在上述背景下，公司须持续进行新技术、新产品的研发，下游市场亦会对新技术、新产品不断提出更高的要求。持续的技术创新能力系公司保持核心竞争力的关键因素，如果公司的技术创新无法跟上行业技术迭代的速度，导致未来相关研发项目无法满足市场需求，或导致相关研发技术与产品无法通过客户验证而实现商业化，则公司可能面临研发失败的风险，将对公司的发展前景和经营业绩产生不利影响。

（2）技术人才流失与核心技术泄密的风险

截至报告期末，公司拥有专利 128 项，其中境内发明专利 72 项，另有软件著作权 71 项，发行人对各项专利及技术等均拥有自主知识产权，并针对全部的核心技术完善了知识产权布局。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 138 人，占员工总数的比例为 24.64%。

核心技术和技术人才是公司保持创新发展的基础。若公司无法持续为技术人才提供更具竞争力的薪酬待遇和发展平台，公司将面临技术人才流失的风险。同时，公司存在因技术人才流失、外界窃取等原因导致核心技术泄密的风险，进而对公司生产经营产生不利影响。

2、经营风险

（1）客户集中及单一客户依赖的风险

公司产品主要面向半导体领域的先进制程，下游主要系半导体设备厂商和芯片产线，由于半导体先进制程领域技术壁垒和投资壁垒较大，下游行业竞争格局呈现集中度较高的状态，导致公司客户集中度亦相对较高。

报告期内，公司前五大客户收入占比分别为 39.31%、61.55%、72.89%及 73.53%，占比较高。公司自研产品批量进入了中微公司、拓荆科技、北方华创等我国头部半导体设备厂商，服务于客户 C、客户 A、客户 B、客户 D 等国内头部芯片产线所致。如果上述主要客户未来的经营状况、技术路线、公司战略、产品价格等发生较大变化，或下游行业竞争格局发生较大变化，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

报告期各期，公司对中微公司销售收入占主营业务收入比例分别为 2.94% 、31.12%、49.19%及 38.89%；对中微公司销售毛利润占公司综合毛利润比例分别为 2.95%、33.90%、52.63%及 43.36%，公司对中微公司具有一定的业绩依赖风险。

如果未来公司无法持续拓展中微公司以外的新客户，或中微公司等主要客户的生产经营情况、经营战略、技术路线、价格等商业条款发生重大不利变化，或行业竞争格局发生重大变化，都将对公司经营业绩产生不利影响。

2026 年 1-6 月，公司对中微销售的主要产品结构有所变化，2024 年及 2025 年主要产品系列的收入有所下降，主要系终端客户对应工艺制程的产线建设进入到尾期，因此需求量有所下降；该终端客户新工艺制程的产线主要需求对应于公司的高压脉冲电源系统产品，已于 2026 年 1-6 月实现业务放量，对冲了产品结构变化影响。

面向半导体先进制程领域的等离子体电源系统产品研发难度较大、技术壁垒较高，且遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的发展规律。未来，若公司未能持续推出新一代的等离子体电源系统产品，可能发生短期内无法胜任下游单一大客户的产品需求的情况。

（2）市场竞争地位变化的风险

等离子体电源系统国产化率较低，市场份额长期被美国、日本等国家的半导体巨头垄断，国内收入成规模的企业相对较少，在自研产品和技术支持服务两个业务板块，公司目前均系国内头部企业，具备较强的市场竞争地位。

一方面，公司依靠多年来的探索与创新，已经具备在先进制程领域对标国际品牌的技术水平，但整体与国际巨头仍存在一定差距，目前仅有技术支持服务业务覆盖了部分国外设备厂商或产线，而自研产品尚未进入国外厂商的供应链；另一方面，随着我国半导体行业的高速增长和国产化进程的不断推进，国内等离子体电源系统市场的竞争亦可能有所加剧。若公司未能持续提升技术水平，保障产品品质并维持核心竞争力，则有可能拉大与国际巨头的差距，或面临更加激烈的竞争，并可能导致公司市场竞争地位发生变化，对公司业绩带来不利影响。

（3）产品商业化进程不达预期的风险

等离子体电源系统属于半导体关键工艺设备中的核心零部件，下游设备厂商和芯片产线对产品性能和稳定性等技术指标有着严苛的要求，一般会经历较长时间的产品验证，才能够导入供应链。公司目前有多款新产品正在客户验证中，若未来公司产品技术水平无法满足客户需求，则可能导致公司产品商业化进程推迟或终止，进而对公司新产品的经营业绩带来不利影响。

3、内部控制风险

（1）管理风险

报告期内，公司业务规模扩张较快，自研产品大规模量产，形成了“自研产品+技术支持服务”的双头发展模式。公司业务规模的增长延伸了公司的管理跨度，增加了公司的管理难度，对公司经营管理能力提出了更高的要求。

本次发行上市后，随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，公司经营管理将面临新的考验。如公司管理层管理水平不能适应公司业务规模迅速扩张的需要，则可能影响公司经营效率和盈利水平。

（2）实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人系朱培文，合计控制公司 64.74%的股份对应的表决权。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，但公司实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等施加重大影响，如实施不当将会损害公司及公司中小股东的利益。

4、财务风险

（1）收入高速增长持续性的风险

报告期内，公司营业收入分别为 26,105.54 万元、44,627.90 万元、65,424.00 万元及 37,545.34 万元，最近三年营业收入复合增长率为 58.31%。随着下游客户国产化需求提升，报告期内，公司自研业务增长迅速，收入高速增长。

未来，随着公司收入达到一定规模，可能会出现收入增速放缓的情况，提醒投资者关注相关风险。

（2）毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 62.56%、66.94%、66.65%及 62.56%，处于较高水平，主要原因是公司下游主要系半导体行业，产品面向先进制程，前期研发投入较大，技术壁垒较高，因此产品毛利率相对较高。

公司 2026 年 1-6 月毛利率有所下降，系产品结构变动所致，高毛利率的 AVG 系列、APG 系列射频电源由于终端产线的建设安排及下游技术迭代，销量下降，而对应的新产品高压脉冲电源系统在 2026 年 1-6 月尚未大规模放量。其他新产品如 Advocate 系列射频电源毛利率相对 AVG 系列、APG 系列较低，导致综合毛利率下降。

公司毛利率水平受下游行业需求、市场竞争、销售产品结构、产品价格、原材料价格、人工成本等多种因素的影响，未来若上述因素发生不利变化，可能会导致公司毛利率出现下降的情况。

公司高毛利率产品亦可能由于下游需求变动或技术迭代，出现销量下降的情况。若公司不能持续开发出新一代的产品，或下游需求出现阶段性波动，都可能导致公司产品结构出现波动，进而导致毛利率出现下滑的风险。

（3）存货规模增加及跌价风险

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 11,323.20 万元、19,514.90 万元、21,265.57 万元及 26,995.18 万元，占流动资产比例分别为 36.39%、36.31%、20.38%及 22.95%，存货跌价准备的余额分别为 1,295.17 万元、1,198.40 万元、1,975.23 万元及 2,486.76 万元，占各期末存货账面余额的比例分别为 10.26%、5.79%、8.50%及 8.43%。

存货规模较大对公司的存货管理能力提出了较高要求，若未来由于公司产品更新迭代、市场环境恶化、客户需求变化等不利因素出现订单需求降低的情况，导致某些原材料或在产品不再满足进一步加工需求，或库存商品出现积压，则可能导致存货跌价风险，影响公司运营效率。

（4）应收账款无法及时回收的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,567.47 万元、16,958.26 万元、20,009.11 万元及 25,604.39 万元，占流动资产的比例分别为 27.53%、31.55%、19.18%及 21.77%。报告期各期末，公司账龄在 1 年以内的应收账款余额保持在 90%以上，账龄结构稳定。

随着公司经营规模和营业收入持续增长，未来应收账款余额可能维持在较高水平。公司客户主要为国内半导体芯片产线或设备厂商头部企业，商业信誉及资金实力较强，但客户自身经营状况与现金流水平受到其发展战略、产业政策、市场环境、收入结构及特征等因素影响。若未来产业政策、市场环境等发生不利变化或主要客户经营业绩、信用状况或履约能力发生不利变化，且公司采取的收款措施未达预期成效，公司应收账款可能存在无法及时收回的风险。

（5）汇率波动的风险

报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例分别系 10.94%、8.74%、6.12%及 12.43%。公司外销产品主要以美元结算，汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入，同时由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产，汇率变动同样会影响财务费用。如未来汇率波动幅度扩大，将对公司经营业绩产生一定的影响。

（6）税收优惠政策变化的风险

发行人为高新技术企业，发行人于 2019 年 12 月 5 日通过了高新技术企业的认定，自 2019 年 1 月 1 日起持续享受企业所得税税率为 15%的税收优惠政策，并分别于 2022 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 19 日通过了高新技术企业复审，企业所得税优惠期直至 2027 年 12 月 31 日，覆盖了公司整个报告期。如果国家所得税相关税收政策发生变化，或公司将来未能获得高新技术企业认定导致适用所得税率发生变化，将影响公司的经营业绩。

5、行业周期的风险

公司主要面向半导体行业，产品系半导体设备中的核心零部件。半导体行业在全球范围内均呈现较强的周期性特点。一般来说，新技术的应用和新产品的创新，会带动终端市场的需求，进而带来半导体行业规模的增长。

目前，全球半导体产业进入了由人工智能、云计算、大数据、高速通信等新技术驱动的新一轮成长阶段。半导体周期的波动以及新技术的应用，将直接影响下游芯片产线对新增产能的战略决策，从而影响其固定资产投资，并最终影响到半导体设备和核心零部件的市场需求。

未来，若因半导体行业周期波动的影响，导致下游芯片产线降低资本开支，则可能会导致半导体设备和核心零部件的市场需求降低，从而对公司自研产品业务板块的收入及利润水平产生不利影响。

6、国际贸易摩擦变化的风险

公司产品及服务主要应用于半导体设备行业。

在自研产品板块，公司主要为国内头部芯片产线和半导体设备企业供货。近年来受国际地缘政治形势影响，国际贸易摩擦有所加剧。若未来相关国家和地区出于贸易保护、地缘政治等原因，进一步通过出口限制等政策加强贸易壁垒，将可能影响国内芯片产线和半导体设备企业生产经营和供应链的稳定性，进而对公司经营发展产生一定的不利影响。公司亦采购了部分海外品牌的元器件，虽然公司不断推进相关元器件的国产化进程，但国际贸易摩擦的加剧仍会对公司供应链稳定产生一定的不利影响。

在技术支持服务领域，为满足半导体行业“精确复制”的特点，公司存在部分采购国际原厂品牌电源系统备机的需求，若国际贸易摩擦加剧，可能导致电源系统备机的价格、交期等受到不利影响。此外，公司技术支持服务客户亦覆盖多个国际知名产线和设备厂商，若国际贸易摩擦加剧，亦可能会影响到相关业务的发展。

7、美国对华跨境投资政策调整的风险

《Provisions Pertaining to U.S. Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern》（简称“《对华投资限制最终规则》”）系美国财政部依据《国际紧急经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act，简称“IEEPA”）制定的跨境投资监管专项规则，于 2024 年 10 月发布、2025 年 1 月正式生效。该规则对美国人士等在中国大陆、中国香港及中国澳门地区半导体和微电子、量子信息技术、人工智能系统三大领域的特定投资设置禁止性规定与强制申报要求，违规交易将面临被美国财政部认定无效、作废、强制剥离对应投资，及民事、刑事追责的法律后果。

截至本上市保荐书出具日，发行人美国背景股东对发行人的历史投资行为不存在违反现行规则的情况。但不排除未来美国有权监管部门修订规则、出台新规或作出不利解释，导致相关投资被认定违规，触发股权强制处置等后果，进而导致发行人股权结构发生重大变动等不利影响，提示投资者关注相关风险。

8、产业政策变化风险

公司报告期内产品主要应用于半导体领域。半导体产业是我国信息技术产业的基础和重要组成部分，半导体行业的发展及国产化的推进对国家产业升级具有至关重要的意义。国家对高质量发展半导体行业高度重视，相继出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》等支持性政策，对行业及公司业务发展起到了积极的促进作用。但若未来国家对半导体相关产业政策发生重大调整，或者下游行业的产业政策出现不利变化，将可能对公司的业务发展或行业需求产生不利影响，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

9、募集资金投资风险

（1）募集资金项目实施的风险

公司本次募集资金主要用于“先进工艺节点集成电路领域电源类零部件研发及产业化项目”、“技术支持服务体系升级扩容项目”、“上海产业化基地建设项目”、“技术研发创新中心建设项目”。如果募集资金不能及时或足额到位，或项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、量产达标等不能按计划顺利实施，则会直接影响项目的投产时间、投资回报及公司的预期收益，进而影响公司的经营业绩。

募集资金投资项目建成后，每年将会产生一定的折旧费用和人工支出，公司若不能及时有效的开拓市场，消化新增的产能，将使募集资金投资项目无法按照既定计划实现预期的经济效益。公司存在可能因固定资产折旧和人工成本的增加而导致利润下滑的风险。

（2）新增产能消化不及预期的风险

本次募集资金投资项目达产后，公司产能将在现有基础上大幅提升。在项目建成后，可能出现宏观经济形势变动、下游市场需求变化、市场竞争格局变化等情况，届时将对项目的新增产能消化带来不利影响。

具体而言，公司本次募集资金投资项目完全达产后，各类等离子体电源系统产能相比报告期情况有较大幅度增长，若下游半导体设备领域增速放缓，对等离子体电源系统的需求亦可能有所下降，则公司本次募集资金投资项目达产后的新增产能可能出现消化速度较慢、影响公司产品销售单价及毛利率的情况。

10、发行失败风险

本次发行的发行结果将受证券市场整体情况、公司经营业绩、公司发展前景及投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。公司存在发行认购不足或未能达到预计市值上市条件的情形而导致发行失败的风险。

11、净资产收益率及每股收益被摊薄的风险

本次发行完成后，公司的净资产规模及股本总额将在短期内大幅增长。由于募集资金投资项目存在一定建设周期，且从投产到产生效益需要一定时间，因此，

本次发行完成后，如果公司的盈利增幅不达预期，则净资产规模及股本总额的扩大将导致公司的净资产收益率和每股收益出现一定幅度的下降。

二、发行人本次发行情况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次公开发行股票总量不超过 2,200 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于公开发行后总股本的 25%；本次发行全部为公司公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【 】元
预计发行日期	【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不超过 8,800 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）
保荐人（主承销商）	国泰海通证券股份有限公司

三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）保荐人和保荐代表人、项目协办人的联系方式

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

保荐代表人：程万里、解明天

项目协办人：史浩博

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电 话：021-3867 6666

传 真：021-3867 6666

（二）项目保荐代表人

本保荐人指定程万里、解明天担任江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

程万里，本项目保荐代表人，曾负责或参与了嘉友国际主板 IPO 项目、嘉友国际可转债项目、嘉友国际非公开发行股票项目、爱科科技科创板 IPO 项目、中

芯国际科创板 IPO 项目、宣泰医药科创板 IPO 项目、通达海创业板 IPO 项目、卓海科技北交所 IPO 项目、东贝 B 股转 A 股项目。程万里先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

解明天，本项目保荐代表人，曾负责或参与了宣泰医药科创板 IPO 项目、通达海创业板 IPO 项目、卓海科技北交所 IPO 项目。解明天先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（三）项目协办人

本保荐人指定史浩博为本次发行的项目协办人。

史浩博：本项目协办人，曾负责或参与了宣泰医药科创板 IPO 项目、通达海创业板 IPO 项目、卓海科技北交所 IPO 项目。史浩博先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（四）项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：沈玉峰、韩锦玮、傅施越、程恺、王祺康、张子尧、王子涵、裘敏杰、李佳。

四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

1、截至本上市保荐书出具日，本保荐人间接持有发行人 0.2536%的股份。上述情况不会影响本保荐人公正履行保荐职责。除上述情况外，以及本保荐人除按照上交所相关规定，安排相关子公司参与发行人本次发行战略配售以外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本上市保荐书出具日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、截至本上市保荐书出具日，本保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

4、截至本上市保荐书出具日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关

联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、截至本上市保荐书出具日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人承诺事项

（一）保荐人对本次上市保荐的一般承诺

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。根据发行人的委托，保荐人组织编制了本次公开发行股票并上市申请文件，同意推荐发行人本次证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

（二）保荐人对本次上市保荐的逐项承诺

保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会、上交所等有关规定对发行人进行了充分的尽职调查和辅导，保荐人有充分理由确信发行人至少符合下列要求：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、

中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

六、保荐人对本次发行上市的推荐结论

在充分尽职调查、审慎核查的基础上，本保荐人认为，神州半导体首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《保荐业务管理办法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件。同意推荐神州半导体本次证券发行上市。

七、本次证券发行上市履行的决策程序

本保荐人对发行人本次发行履行决策程序的情况进行了核查。经核查，本保荐人认为，发行人本次发行已履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上交所规定的决策程序。具体情况如下：

（一）董事会审议过程

2026 年 2 月 14 日，发行人召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（二）股东会审议过程

2026 年 3 月 2 日，发行人召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了上述与本次发行上市相关的议案。

八、保荐人关于发行人符合科创板定位及国家产业政策的说明

（一）发行人符合科创板定位的说明

1、发行人符合科创板行业定位

公司主要从事半导体关键工艺设备核心零部件的研发、生产、销售和技术支持服务，以半导体制造关键工艺技术——等离子体源技术为基础，为我国半导体先进制程产业链提供高端等离子体电源系统产品和全方位技术支持服务。公司主要产品包括等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统、高压脉冲电源系统等，

并为芯片产线提供相应技术支持服务。

公司所处行业根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》隶属于“C35专用设备制造业”之“C3562 半导体器件专用设备制造”；根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》隶属于“新一代信息技术产业（1）”之“电子核心产业（1.2）”之“新型电子元器件及设备制造（1.2.1）”；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》，隶属于“（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”之“半导体和集成电路”行业。

由上可知，公司符合科创板行业定位。

2、保荐人核查情况

（1）核查内容、方法及过程

1)将发行人的主营业务、主要产品与《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的行业分类进行比对，并核查与可比公司的行业领域归类是否存在显著差异；

2)将发行人的主营业务、主要产品与《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》进行比对，核查发行人的主营业务和主要产品是否属于国家战略性新兴产业；

3）保荐人对比了发行人与同行业可比公司相关业务及产品情况，核查发行人主营业务及产品与同行业可比公司相比是否具有竞争力，是否符合科创板定位；

4）获取并查阅了发行人由政府授权颁发的高新技术企业证书等相关业务许可、资质。

（2）核查结论

经核查，根据科创板行业分类，根据《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》隶属于“新一代信息技术产业（1）”之“电子核心产业（1.2）”之“新型电子元器件及设备制造（1.2.1）”。

（二）发行人符合科创属性要求的核查情况

发行人具有科创属性，符合《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的要求，公司科创属性的符合情

况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投入金额≥8,000 万元	√是 □否	公司最近三年累计研发投入合计 20,383.07 万元，占最近三年累计营业收入比例为 14.97%，超过 5%且超过 8,000 万元，符合条件
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	√是 □否	截至 2025 年末，公司的研发人员数量为 124 人，占当年员工总数的比例为 24.46%，超过 10%，符合条件
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	√是 □否	截至 2026 年 6 月 30 日，发行人形成主营业务收入的发明专利为 71 项，符合条件
最近三年营业收入复合增长率≥25%，或最近一年营业收入金额≥3 亿元	√是 □否	公司 2025 年营业收入金额为 6.54 亿元，超过 3 亿元，符合条件

1、保荐人核查情况

（1）核查内容、方法及过程

1）查阅了报告期内发行人申报会计师出具的《审计报告》，核查了发行人主营业务收入构成情况、研发投入构成情况；

2）通过对发行人高级管理人员、核心技术人员及相关人员进行访谈了解商业模式、核心技术和创新机制，对发行人行业归属进行了分析；

3）查阅了发行人与主要客户的销售合同，及主要供应商的采购合同，并对于公司主营业务、主要产品进行了核实；对报告期内主要客户、供应商进行了访谈，了解发行人与主要客户、供应商的业务合作情况，了解上下游企业所处行业分布及其对发行人的评价；

4）获取并查阅了发行人由政府授权颁发的高新技术企业证书等相关业务许可、资质；

5）查阅了公司重大科研项目开发协议、项目阶段性验收文件等，了解项目研发内容、研发成果、项目进展和目前的阶段性成果等；

6）取得了协会、公司主要客户出具的说明函，查阅了公司承担的国家重大项目相关文件，确认了公司核心技术领先、相关国家重大项目攻关内容与公司主营业务与核心技术直接相关、公司核心技术与主要产品对于国家战略具有重大意义；

7）获取并查阅了行业研究报告及同行业公司公开披露信息，了解公司所处

行业市场竞争格局及下游市场未来发展趋势，确认了公司所处行业成长性较强；

8）取得发行人专利清单，分析与主营业务收入的关系，确认应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利的数量满足条件。

（2）核查结论

发行人科创属性符合《科创属性评价指引（试行）》第二条和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》第七条的相关规定。

九、保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明

本保荐人对发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查。经核查，本保荐人认为发行人本次发行符合《上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

（一）符合中国证监会规定的发行条件

1、发行人组织机构健全，持续经营满 3 年，符合《注册管理办法》第十条的规定

（1）保荐人查验了发行人工商档案，发行人改制设立有关内部决策、审计、评估及验资文件，并核查了发行人现行有效的公司章程及报告期内的财务报表及审计报告。发行人前身神州有限于 2016 年 4 月注册成立，并以股改基准日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算，发行人持续经营时间在三年以上。

经核查，保荐人认为：发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，符合《注册管理办法》第十条的规定。

（2）保荐人查阅了发行人历次股东大会（股东会）、董事会、监事会、董事会专门委员会的会议文件，股东大会（股东会）、董事会和监事会议事规则以及相关制度文件。

经核查，保荐人认为：发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、发行人会计基础工作规范，内控制度健全有效，符合《注册管理办法》第十一条的规定

（1）保荐人查阅了发行人有关财务基础资料和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]210Z0307 号），核查了发行人的重要会计科目明细账、重大合同、财务制度、经主管税务机关确认的纳税资料等资料。

经核查，保荐人认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

（2）保荐人查阅了发行人各项内部控制制度，核查了发行人报告期内重大违法违规情况，并查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]210Z0311 号）。

经核查，保荐人认为：发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《注册管理办法》第十二条的规定

（1）符合《注册管理办法》第十二条第（一）款的规定

1）保荐人查阅了发行人主要财产的权属凭证、相关合同等资料，对发行人运营情况进行尽职调查。经核查，发行人具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，发行人资产完整。

2）保荐人查阅了发行人股东大会（股东会）、董事会、监事会会议资料，查看了发行人聘任高级管理人员的相关协议，抽查了签署的《劳动合同》，取得了发行人及其董事、监事、高级管理人员的书面确认，以及对有关人员进行了访谈。经核查，截至本上市保荐书出具日，发行人总经理、副总经理、财务负责人

和董事会秘书等高级管理人员在担任相应职务期间，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，发行人人员独立。

3）保荐人查阅了发行人及其子公司的财务管理制度，对发行人财务部门等有关人员进行了访谈和征询，复核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]210Z0311 号）。经核查，发行人已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策；具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，发行人财务独立。

4）保荐人查阅了发行人的公司章程、三会议事规则等制度文件，了解发行人的公司治理结构、组织机构和职能部门的设置情况，访谈了发行人相关高级管理人员。经核查，发行人已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形，发行人机构独立。

5）保荐人取得了发行人控股股东、实际控制人出具的关于避免同业竞争的承诺，查阅了发行人与关联企业签订的相关合同。经核查，发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，发行人业务独立。

综上，保荐人认为：发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）款的规定。

（2）符合《注册管理办法》第十二条第（二）款的规定

保荐人核查了发行人重大采购合同及主要供应商等资料，了解发行人主营业务开展情况；查阅了报告期内发行人历次股东大会（股东会）、董事会、监事会及董事会专门委员会会议资料，取得了最近 2 年内发行人核心技术人员名单、简

历、劳动合同等资料，对发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况及原因进行了核查。保荐人查阅了发行人工商档案、控股股东、实际控制人出具的说明文件，并复核了发行人律师出具的法律意见书。

经核查，保荐人认为：发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，核心技术人员稳定且最近二年内没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更，符合《注册管理办法》第十二条第（二）款的规定。

（3）符合《注册管理办法》第十二条第（三）款的规定

保荐人查阅了发行人的经营资料、重大资产权属文件、财务报告和审计报告、企业信用报告等资料，核查发行人涉及诉讼仲裁等情况，并与发行人律师进行了沟通核实，分析相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等，访谈了发行人相关高级管理人员。

经核查，保荐人认为：发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）款的规定。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条的规定

（1）保荐人核查了发行人营业执照、公司章程、主营业务实际经营情况及开展相关业务所涉及的准入许可及相关资质情况，查阅了与发行人所从事行业相关的国家产业政策。

经核查，保荐人认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第（一）款的规定。

（2）保荐人核查了报告期内发行人及其控股股东、实际控制人的涉诉情况，通过网络检索查询上述主体涉及诉讼、仲裁、贿赂、行政处罚等相关情形，查阅了相关主管部门出具的合规证明，并与发行人律师进行了沟通核实。

经核查，保荐人认为：最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第（二）款的规定。

（3）保荐人取得并查阅了董事、监事和高级管理人员提供的无犯罪证明、调查表及中国证监会等网站检索等资料，核对发行人律师出具的法律意见。

经核查，保荐人认为：发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第（三）款的规定。

（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元

经核查，发行人本次发行前总股本为 6,600 万股，公司本次拟公开发行股票不超过 2,200 万股，发行人本次发行后总股本不超过 8,800 万股，发行后发行人股本总额不低于人民币 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上

经核查，本次发行后，公司股本总额不超过人民币 4 亿元，本次拟发行股份占发行后总股本的比例达到 25%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定。

（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准

发行人选择的上市标准为《上市规则》第二章 2.1.2 中规定的第（一）条：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”

根据容诚会计师出具的审计报告，2024 年度、2025 年度公司净利润（扣非后孰低）分别为 13,359.95 万元、19,827.12 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。结合公司同行业可比公司在境内市场近期估值情况，基于对公司市值的预先评估，预计公司本次发行后总市值不低于人民币 10 亿元，满足市值及财务指标标准。

（五）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

十、保荐人对发行人持续督导工作的安排

本保荐人对发行人持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度，督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，并承担下列工作：

（一）督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

（二）督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

（三）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

（四）持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

（五）持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

（六）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页）

项目协办人：

史浩博

保荐代表人：

程万里　　解明天

内核负责人：

杨晓涛

保荐业务负责人：

郁伟君

法定代表人（董事长）：

朱　健

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 11 月 16 日